

[20013]

過酷環境に対応可能な新規パワーFET デバイスの創出

Fabrication of advanced power FET devices for harsh environment application

修士論文

[1] 玉村達哉、パワーデバイス応用を指向した強誘電体ゲート型ダイヤモンド FET の開発、金沢大学大学院自然科学研究科電子情報科学専攻

卒業論文

[1] 徳川奎史、強誘電体ゲート FET の放射線耐性に関する検証、金沢大学理工研究域電子情報通信学類

招待講演等

[1] T. Kawae, Inspection of pseudo normally-off operation of ferroelectric gate diamond FET (Invited), 4th international seminar on metallurgy and materials (ISMM2020)